

## 大見研究室 和文 論文リスト

### 2010 年

- 1221(B) 大見忠弘、「1.1 集積回路プロセス技術の発展、1.2 デバイス作製プロセス」、電子情報通信学会「知識ベース」(電子情報通信学会)、10 群 2 編集積回路製造技術、1 章集積回路プロセス技術概論、  
<http://www.ieice-hbkb.org/portal/>  
2010 年 2 月。
- 1222(W) 大見忠弘、「作るために必要な全エネルギーより十分大きなエネルギーを発電する太陽電池: 薄膜シリコン太陽電池」。JAPAN GREEN NEWDEAL FORUM 2010、(ベンチャー支援機構 TSUNAMI)、pp.35-55、2010 年 4 月。
- 1223(W) 寺本章伸、藤澤孝文、阿部健一、須川成利、大見忠弘、「RTS におけるキャリアトラップ準位の統計的評価」、シリコンテクノロジー、No.127、(応用物理学会分科会)、pp.25-30、2010 年 7 月。
- 1224(M) 大見忠弘、「NEWS 最先端 学問に基づいた本物のシリコン技術の時代はこれから始まる!!」、半導体シニア協会会報 Encore、(SSIS半導体シニア協会)、No.67、pp.14-19、2010 年 7 月。
- 1225(C) 阿部健一、寺本章伸、須川成利、大見忠弘、「RTN 測定の高精度化・高速化技術と RTN 特性に強い影響度を示すプロセス条件」、映像情報メディア学会技術報告、((社)映像情報メディア学会)、Vol.34、No.38、IST2010-47、pp.29-32、2010 年 9 月。
- 1226(W) 田中宏明、黒田理人、中尾幸久、寺本章伸、須川成利、大見忠弘、「ULSI 用低抵抗コンタクトのための低バリアハイトメタルシリサイドの形成」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.110、No.241、シリコン材料・デバイス、(電子情報通信学会)、SDM2010-157、pp.25-30、2010 年 10 月。
- 1227(W) 諏訪智之、熊谷勇喜、寺本章伸、大見忠弘、服部健雄、「酸素ラジカルを用いて形成した SiO<sub>2</sub>/Si 界面における組成偏移と価電子帯オフセットの基板面方位依存性」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.110、No.241、シリコン材料・デバイス、(電子情報通信学会)、SDM2010-167、pp.61-65、2010 年 10 月。
- 1228(W) 服部真季、小瀬村大亮、武井宗久、永田晃基、赤松弘彬、富田基裕、水上雄輝、橋口裕樹、山口拓也、小椋厚志、諏訪智之、寺本章伸、服部健雄、大見忠弘、小金澤智之、廣沢一郎、「原子スケールで平坦な SiO<sub>2</sub>/Si 酸化膜界面歪の評価」、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.110、No.241、シリコン材料・デバイス、(電子情報通信学会)、SDM2010-170、pp.71-75、2010 年 10 月。
- 1229-1(C) 寺本章伸、阿部健一、須川成利、大見忠弘、「MOSFET におけるランダムテレグラフシグナルの統計的評価方法」、招待講演、応用物理学会分科会シリコンテクノロジー、No.128、pp.17-22、2010 年 11 月。
- 1229-2(W) 寺本章伸、阿部健一、須川成利、大見忠弘、「MOSFET におけるランダムテレグラフシグナルの統計的評価方法」、招待講演、電子情報通信学会技術研究報告、Vol.110、No.274、シリコン材料・デバイス(電子情報通信学会)SDM2010-174、pp.17-22、2010 年 11 月。
- 1230(W) 大見 忠弘、須川成利、小谷光司、平山昌樹、後藤哲也、宮本直人、黒田理人、田中宏明、諏訪智之、中尾幸久、大橋朋貢、橋本昌和、「超高性能フル CMOS システム LSI が切り拓く学問に基づく本物のシリコン技術」、第 22 回マイクロエレクトロニクス研究会プロシーディング、pp.45-81、2010 年 11 月。